

05,07

Кристаллическая структура, пьезо- и диэлектрические свойства нового ряда твердых растворов $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$)

© С.В. Зубков, Ю.А. Куприна

НИИ физики, Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: svzubkov61@mail.ru

Поступила в Редакцию 22 октябрь 2025 г.

В окончательной редакции 22 октября 2025 г.

Принята к публикации 24 октября 2025 г.

Керамика Ауривиллиуса–Смоленского (АС) $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$), число перовскитоподобных слоев $n = 2$ была синтезирована (для $x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) традиционным путем твердофазной реакции. По данным рентгеновской порошковой дифракции было установлено, что все соединения являются однофазными со структурой фаз АС (число перовскитоподобных слоев $n = 2$) с орторомбической кристаллической решеткой (пространственная группа $A2_1am$). Были рассчитаны параметры кристаллической решетки a, b, c , измерены относительная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$, тангенс угла диэлектрических потерь $\tan \delta$, температура Кюри T_C , пьезомодуль d_{33} .

Ключевые слова: фазы Ауривиллиуса–Смоленского, температура Кюри, микроструктура, диэлектрическая проницаемость, пьезомодуль.

DOI: 10.61011/FTT.2025.10.61971.290-25

1. Введение

В 1949 г. при изучении системы $\text{Bi}_2\text{O}_3\text{—TiO}_2$ В. Ауривиллиус установил образование оксида $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ со структурой типа перовскита [1]. Спустя десять лет группа Г. Смоленского [2] открыла сегнетоэлектрические свойства в $\text{Bi}_2\text{PbNb}_2\text{O}_9$, относящегося к этому семейству соединений, после чего начался интенсивный этап исследования данных соединений. В связи с этим, по праву, эти соединения можно назвать фазами Ауривиллиуса–Смоленского (ФАС) [3]. В 1961–1962 гг. Е.С. Суббарао получил около десяти новых соединений, почти все они оказались сегнетоэлектриками [4,5]. В настоящее время синтезированы сотни ФАС. Они образуют большое семейство висмут-содержащих слоистых соединений типа перовскита, химический состав которых описывается общей формулой $\text{Bi}_2A_{m-1}B_m\text{O}_{3m+3}$. Кристаллическая структура ФАС включает чередующиеся слои $[\text{Bi}_2\text{O}_2]^{2+}$, разделенные m перовскитоподобными слоями $[A_{m-1}B_m\text{O}_{3m+1}]^{2-}$, где А-позиции заняты ионами большого радиуса: Na^+ [6], K^+ [7], Ca^{2+} [8], Sr^{2+} [9], Ba^{2+} [10], Pb^{2+} [11], Y^{3+} [12,13], Bi^{3+} , La^{3+} [14], Nd [15], Sm [16], Gd [17], Ce [18], Tb [19], Dy [20], Ho [21], Er [22], Eu [23] и Ac , Th , Pr (актиниды), которые демонстрируют додекаэдрическую координацию. В-позиции внутри кислородных октаэдров заняты высокочargedными ($\geq 3^+$) катионами малого радиуса: Fe , Cr , Mn , Co [24–26], а также Cu^{2+} [27], Mg^{2+} [28], Ti^{4+} , W^{6+} [29], Nb^{5+} [30], Ta^{5+} [31]. Значение m определяется числом слоев перовскита m $[A_{m-1}B_m\text{O}_{3m+1}]^{2-}$, расположенных между флюоритоподобными слоями $[\text{Bi}_2\text{O}_2]^{2+}$ вдоль псевдотетрагональной оси c [32], и может быть

целым или полуцелым [33] числом в диапазоне 1–5. Замещения атомов в позициях А и В существенно влияют на электрические свойства ФАС. Имеют место большие изменения диэлектрической проницаемости и электропроводности; кроме того, температура Кюри T_C также может изменяться в широких пределах. Таким образом, изучение катион-замещенных соединений ФАС имеет большое значение при разработке материалов различного технического назначения.

$\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$ (SBN) является одним из наиболее перспективных кандидатов для энергонезависимой памяти с произвольным доступом и резонаторов с точностью изменения частоты (около 15%) [34–36].

Проведены многочисленные исследования, направленные на улучшение сегнетоэлектрических и пьезоэлектрических свойств керамики SBN путем ионного легирования [37,38]. Легирование Pr, Nd и La позиции Bi в SBN приводит к релаксационному поведению [39–41]. Также сообщалось о высоком пьезомодуле $d_{33} \leq 20$ pC/N, низких диэлектрических потерях SBN [42–45] и превосходных свойствах отсутствия усталости [46–50].

Настоящая работа направлена на исследование влияния изоморфного замещения на пьезосвойства синтезированного ряда $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$).

2. Эксперимент

Поликристаллический ряд ФАС $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) был синтезирован твердофазной реакцией соответствующих оксидов Bi_2O_3 ,

Таблица 1. Длины связей в кислородном октаэдре для $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$

№	Образец	$l(\text{Nb}_1-\text{O}_1)$	$l(\text{Nb}_2-\text{O}_2)$	$l(\text{Nb}_4-\text{O}_4)$	$l(\text{Nb}-\text{O}_5)$
1	$\text{SrBi}_2\text{NbTaO}_9$	2.1465	1.9295	2.0698	2.06287
2	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.2}\text{Ta}_{0.8}\text{O}_9$	2.1471	1.93101	2.0698	2.0623
3	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.4}\text{Ta}_{0.6}\text{O}_9$	2.144	1.9274	2.0698	2.0624
4	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.6}\text{Ta}_{0.4}\text{O}_9$	2.1455	1.92877	2.0698	2.0623
5	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.8}\text{Ta}_{0.2}\text{O}_9$	2.1437	1.9271	2.0709	2.065
6	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$	2.1456	1.9288	2.0698	2.0623

SrCO_3 , Ta_2O_5 , Nb_2O_5 . Все исходные соединения были марки ЧДА (аналитической чистоты). После взвешивания по стехиометрическому составу и тщательного измельчения исходных оксидов с добавлением этилового спирта прессованные образцы прокаливали при температуре 860–870°C в течение 4 h. Обжиг образцов проводился в лабораторной муфельной печи на воздухе. Затем образец дробили, многократно измельчали и прессовали в таблетки диаметром 9 mm и толщиной 1.0–1.5 mm с последующим финальным синтезом при температуре 1140°C (2 h). Рентгенограмма регистрировалась на дифрактометре Rigaku Ultima IV с Cu-рентгеновской трубкой. Излучение $\text{Cu } K_{\alpha_1, \alpha_2}$ было выделено из общего спектра с помощью Ni-фильтра. Рентгенограмму измеряли в диапазоне углов 2θ от 10 до 60° с шагом сканирования 0.02° и экспозицией (время регистрации интенсивности) 4 s на точку. Анализ профиля рентгенограммы, определение положения линий, их индексация (hkl) и уточнение структуры проведено методом Ритвельда в программе Full Prof Suitt. Для измерения диэлектрической проницаемости и электропроводности на плоские поверхности исследуемых образцов наносились электроды с использованием Ag-пасты, отожженной при температуре 720°C (20 min). Температурные и частотные зависимости диэлектрических характеристик измерялись с помощью измерителя иммитанса Е7-20 в диапазоне частот от 100 kHz до 1 MHz и в интервале температур от комнатной до 500°C. Для измерения пьезомодуля d_{33} образец подвергался поляризации в масляной бане при 150°C при напряжении 45–65 kV/cm в течение 30 min. Значение пьезомодуля исследуемых соединений находили из соотношения с известным значением пьезомодуля эталонного образца кварца X-среза.

3. Результаты и их обсуждение

Порошковые рентгенограммы всех исследованных твердых растворов $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) соответствуют однофазным ФАС с $m = 2$ и не содержат дополнительных рефлексов. Эти соединения изоструктурны известному перовскитоподобному оксиду ФАС SBN. Все пики были проиндексированы на основе орторомбических ячеек, связанных с пространственной группой $A2_1am$, которая соответствует файлу

JCPDS под номером № 49-0617 (№ 36 в программе PCW 2.4). На рис. 1, а представлены экспериментальные порошковые рентгенограммы исследуемых соединений $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$). Пик (115) на рентгенограмме рис. 1, а показывает самую высокую интенсивность в плоскости $(11(2m+1))$. Этот типичный дифракционный пик соответствует слоистой структуре SBN [51].

В табл. 1 приведены длины связей Nb/Ta–O для ряда $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$).

3.1. Кристаллическая решетка

По данным рентгеновской дифракции были определены параметры элементарной ячейки (постоянные решетки a_0 , b_0 , c_0 и объем V), которые приведены в табл. 2.

В табл. 2 приведены параметры орторомбической δb_0 и тетрагональной $\delta c'$ деформации; средний тетрагональный период a_t , средняя толщина одного перовскитоподобного слоя c' , где $c' = 3c_0/(8+6m)$, $a_t = (a_0 + b_0)/(2\sqrt{2})$ — среднее значение тетрагонального периода; a_0 , b_0 , c_0 — периоды решетки; $\delta c' = (c' - a_t)/a_t$ — отклонение ячейки от кубической формы, то есть удлинение или сокращение кубической формы; $\delta b_0 = (b_0 - a_0)/a_0$ — орторомбическая деформация [52,53]. В.М. Гольдшмидтом [54] был введен толеранс-фактор t , как геометрический критерий, определяющий степень устойчивости и искажения кристаллической структуры:

$$t = (R_A + R_O)/\sqrt{2}(R_B + R_O), \quad (1)$$

где R_A и R_B — радиусы катионов в подрешетке A и B соответственно; R_O — ионный радиус кислорода. Очевидно, что значение t для всего ряда синтезированных соединений имеет одно и то же значение. В настоящей работе толеранс-фактор рассчитывался с учетом таблицы ионных радиусов Р.Д. Шеннона [55] для соответствующих координационных чисел (КЧ): O^{2-} (КЧ = 6), $R_{\text{O}^{2-}} = 1.40 \text{ \AA}$; Ta^{5+} (КЧ = 12), $R_{\text{Ta}^{5+}} = 0.64 \text{ \AA}$; Nb^{5+} (КЧ = 12), $R_{\text{Nb}^{5+}} = 0.64 \text{ \AA}$. Шеннон не привел ионный радиус Bi^{3+} для координации с КЧ = 12. Поэтому его значение определялось из ионного радиуса с КЧ = 6

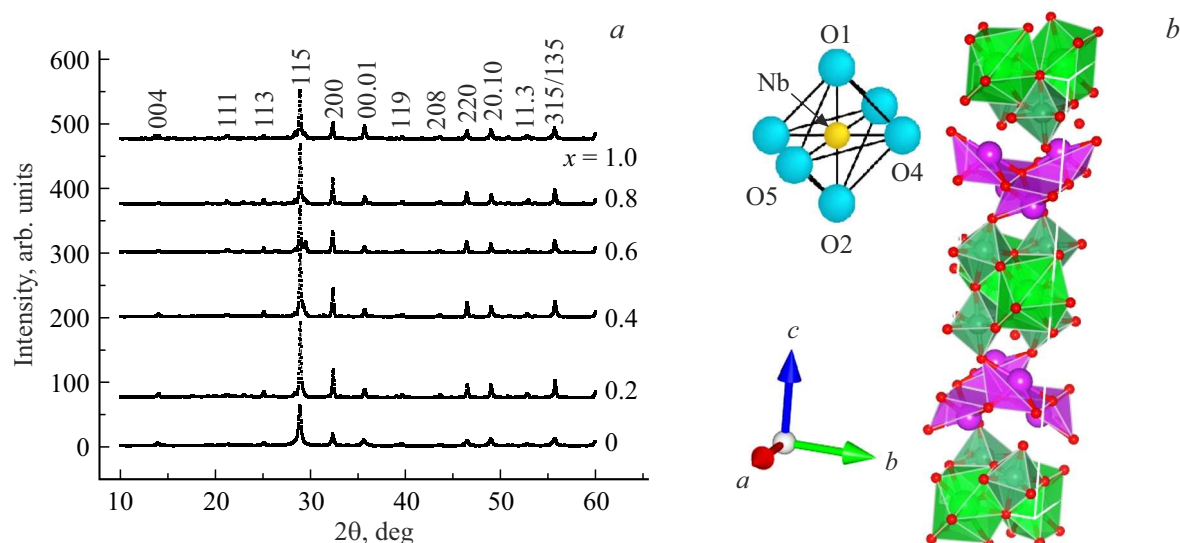


Рис. 1. *a)* Рентгеновские дифрактограммы керамики $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) в диапазоне 2θ 10–60°. *b)* Кристаллическая структура $\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$, изображенная с решеткой, и позиционные параметры в кислородном октаэдре.

Таблица 2. Параметры элементарной ячейки a_0 , b_0 , c_0 , V , a_t — параметр тетрагонального периода, c' — высота октаэдра по оси c , $\delta c'$ — отклонение от кубической формы, δb_0 — ромбическое искажение

№	Образец	a_0 , Å	b_0 , Å	c_0 , Å	c'	a_t	$\delta c'$	δb_0	V , Å ³
1	$\text{SrBi}_2\text{NbTaO}_9$	5.5103	5.513	25.0648	3.7686	3.9064	–3.52	0.235	761.425
2	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.2}\text{Ta}_{0.8}\text{O}_9$	5.5072	5.5142	25.0072	3.76365	3.9068	–3.66	0.216	759.413
3	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.4}\text{Ta}_{0.6}\text{O}_9$	5.5064	5.5168	25.0356	3.7674	3.9043	–3.5	0.345	760.275
4	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.6}\text{Ta}_{0.4}\text{O}_9$	5.5062	5.517	25.0537	3.7656	3.9046	–3.56	0.235	761.074
5	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_{1.8}\text{Ta}_{0.2}\text{O}_9$	5.5109	5.5197	25.0317	3.767	3.905	–3.53	0.217	761.427
6	$\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$	5.5059	5.5167	25.054	3.768	3.904	–3.48	0.315	761.

($R_{\text{Bi}^{3+}} = 1.17$ Å), умноженного на коэффициент аппроксимации 1.179, тогда для Bi^{3+} (КЧ = 12) $R_{\text{Bi}^{3+}} = 1.38$ Å.

Как видно из табл. 2, $\delta c'$ имеет отрицательное значение, что соответствует „сжато“ состоянию октаэдра в перовскитовом слое [56,57].

Практически все параметры ячеек остаются постоянными, что и ожидаемо при изоморфном замещении Nb на Ta.

3.2. Диэлектрические свойства

Зависимости относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon/\varepsilon_0$ и тангенса угла диэлектрических потерь $\text{tg } \delta$ от температуры для ФАС $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$), число перовскитоподобных слоев $n = 2$ представлены на рис. 2 и 3 соответственно, при значениях частоты от 100 kHz до 1 MHz для керамик, спеченных при температурах 1140–1150°C.

Максимум диэлектрической проницаемости $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$, соответствующий фазовому переходу сегнетоэлектрик–параэлектрик, отчетливо наблюдается для всего ряда

твердых растворов $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$), $n = 2$ на частотах от 100 kHz до 1 MHz. Для ряда $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.2, 0.4, 1.0$), $n = 2$ можно также наблюдать уменьшение $\text{tg } \delta$ практически в десять раз по сравнению с SBN, для ряда $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.6, 0.8$) — в 2 раза. Уменьшение $\text{tg } \delta$ для всего ряда $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) можно объяснить уменьшением дефектности кристаллической структуры и, как следствие, кислородных вакансий. Уменьшение дефектности связано с тем, что замещение Nb на Ta делает связи (Ta,Nb)–O менее ковалентными. Поскольку 5d-орбиталь Ta более протяжена, чем 4d-орбиталь Nb, гибридизация 5d-орбитали Ta с O2p уменьшает энергию связи и делает связь менее ковалентной. Ковалентность играет важную роль в структурных искажениях и сегнетоэлектричестве в сегнетоэлектрических оксидах [58]. Таким образом, уменьшение ковалентного взаимодействия в октаэдрическом звене приводит к уменьшению структурных искажений и к уменьшению значений температуры Кюри T_C .

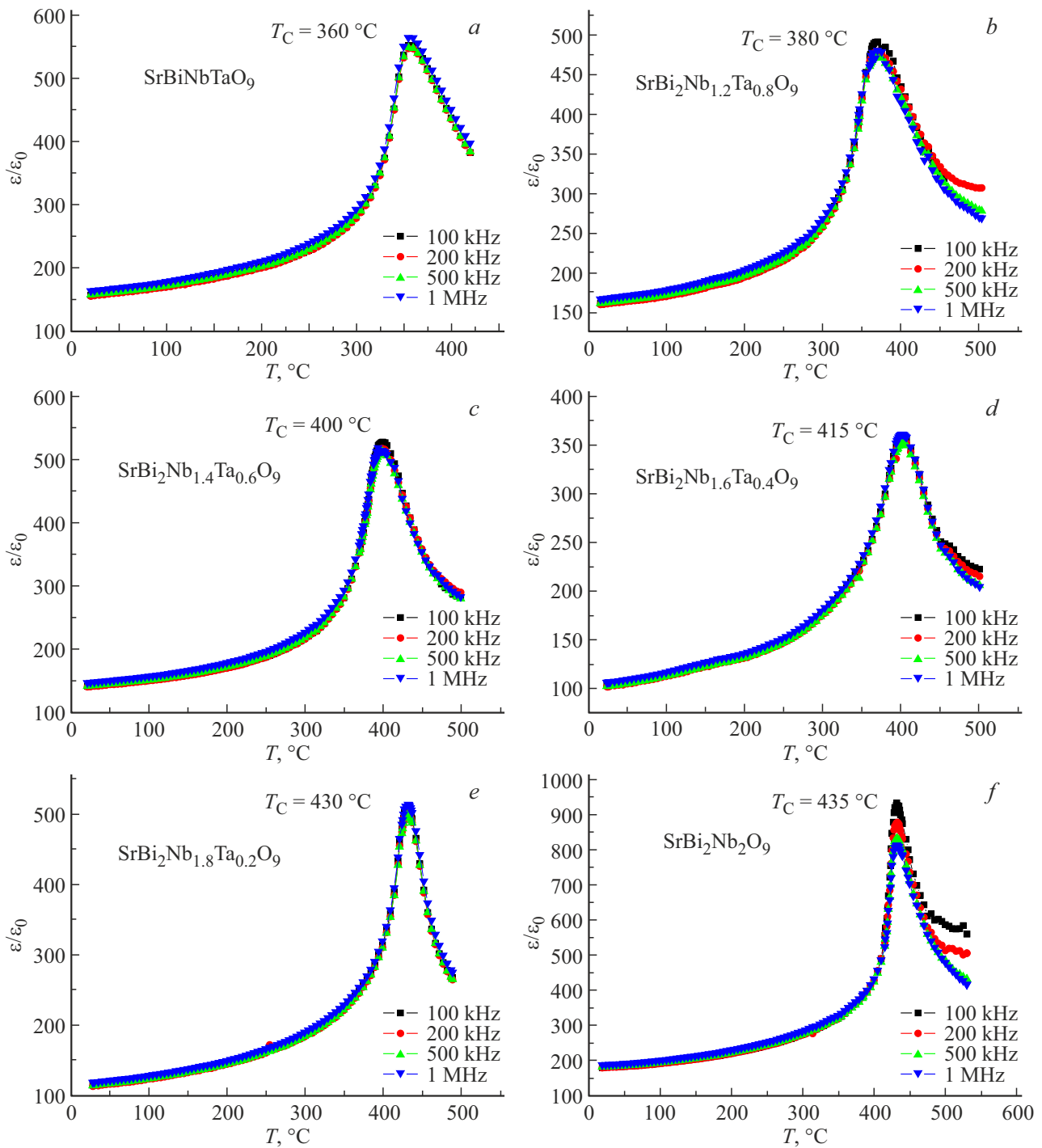


Рис. 2. Температурные зависимости относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$ для $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$).

Для всего ряда $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) наблюдается отсутствие дисперсии $\varepsilon/\varepsilon_0(T)$ по частоте. Для $\text{tg } \delta$ у $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.2, 0.4$) в интервале $x = 0.2-0.4$ не наблюдается привычной зависимости температуры Кюри T_C и минимума значения $\text{tg } \delta$ (см. рис. 3, *f* и *e*). Кроме того, наблюдается смещение минимума $\text{tg } \delta$ в сторону больших значений для $x = 0$ от температуры фазового перехода, что может быть

косвенным признаком релаксорных свойств $\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$, с одной стороны. С другой стороны, замещение Nb на Ta при значениях $x = 0.2$ связано с уменьшением кислородных вакансий и уменьшением диэлектрических потерь. О том, что при концентрации $x = 0.2$ не происходит замещения Nb на Ta в кислородном октаэдре, можно судить о незначительном изменении температуры Кюри $T_C = 435$ и 430°C для $x = 0.0$ и 0.2 соответственно.

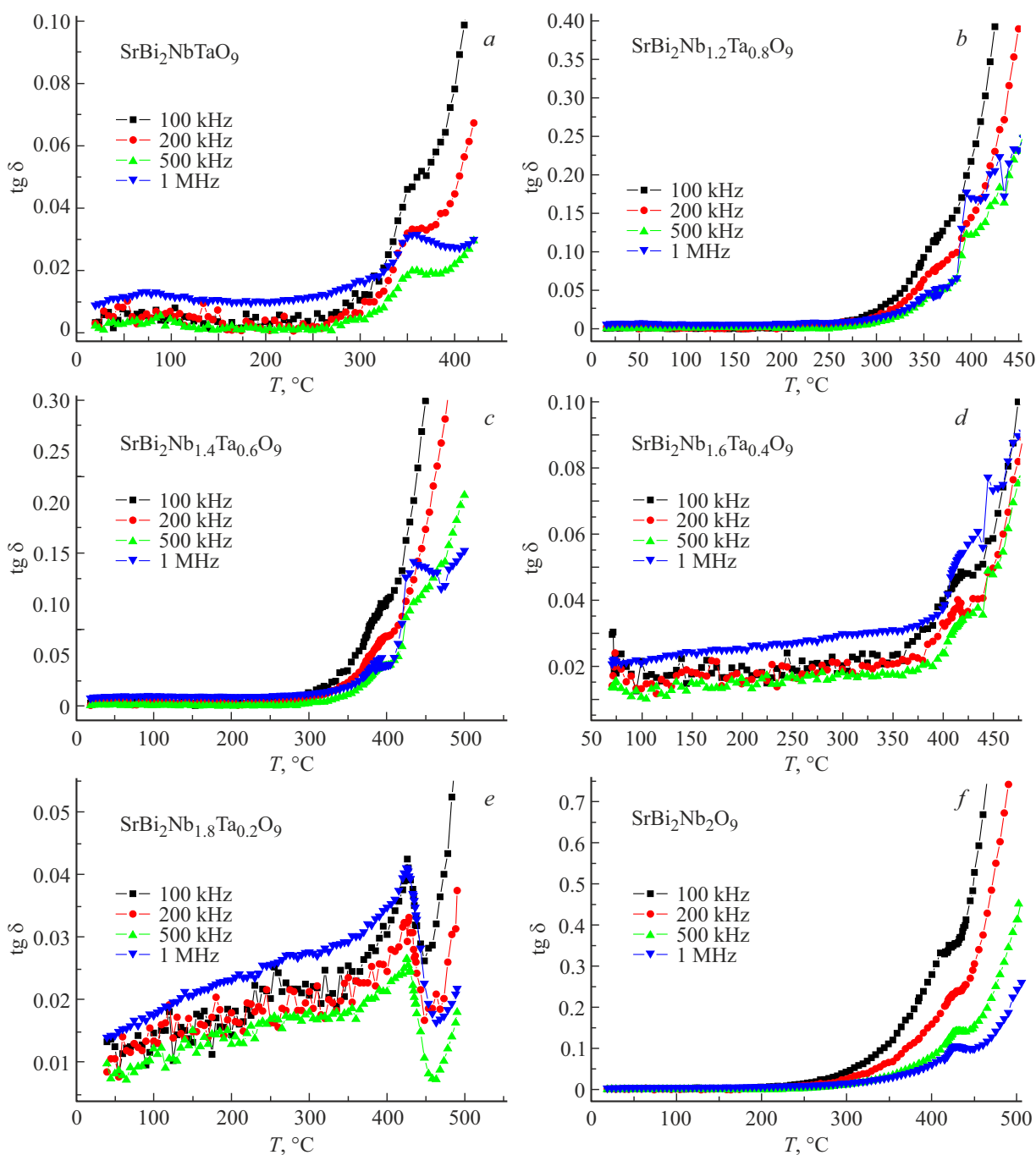


Рис. 3. Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь $\text{tg } \delta$ для $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$).

В табл. 3 приведены температуры фазового перехода T_C при увеличении параметра x . Температура Кюри T_C уменьшается практически линейно с увеличением x .

Как видно из табл. 3, температура фазового перехода T_C проявляет практически линейную зависимость от параметра x .

3.3. Пьезоэлектрические измерения

Для измерения пьезомодуля d_{33} образец подвергался поляризации в масляной бане при 150°C при напряже-

нии $45\text{--}65\text{ kV/cm}$ в течение 30 min. Значение пьезомодуля, исследуемых соединений, находили из соотношения с известным значением пьезомодуля эталонного образца кварца X-среза. Значение пьезоэлектрической константы d_{33} для стехиометрической керамики SBN составило 14 pC/N и хорошо согласуется с опубликованными значениями [59]. Для составов $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.2, 0.4, 0.6$) значения пьезомодуля лежат в интервале $16\text{--}17\text{ pC/N}$, для $\text{SrBi}_2\text{Nb}_{2-x}\text{Ta}_x\text{O}_9$ ($x = 0.8, 1.0$) — в интервале $12\text{--}14\text{ pC/N}$. Рост пьезомодуля от 14 до 17 pC/N можно связать с уменьшением дефектности

Таблица 3. Температура Кюри T_C , относительная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon/\varepsilon_0$ и тангенс потерь $\tan \delta$, измеренные на частоте 100 kHz, пьезомодуль d_{33}

№	Состав	T_C , °C	$\varepsilon/\varepsilon_0$	d_{33} , pC/N	$\tan \delta$ (100 kHz)
1	SrBi ₂ NbTaO ₉	360	580	14	0.05
2	SrBi ₂ Nb _{1.2} Ta _{0.8} O ₉	380	490	12	0.14
3	SrBi ₂ Nb _{1.4} Ta _{0.6} O ₉	400	528	17	0.1
4	SrBi ₂ Nb _{1.6} Ta _{0.4} O ₉	415	360	16	0.05
5	SrBi ₂ Nb _{1.8} Ta _{0.2} O ₉	430	513	17	0.04
6	SrBi ₂ Nb ₂ O ₉	435	935	14	0.38

соединений и уменьшением степени ковалентности и совершенно не связано с уменьшением ковалентности связей в кислородном октаэдре.

4. Выводы

Выполнены исследования электрофизических свойств перовскитоподобных оксидов АС твердых растворов SrBi₂Nb_{2-x}Ta_xO₉ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$). Керамика была изготовлена традиционным методом твердофазной реакции. Рентгенограммы проиндексированы как орторомбические A2₁am для всех твердых растворов ФАС. Изоморфное замещение Nb на Ta для состава SrBi₂Nb_{2-x}Ta_xO₉ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) привело к уменьшению температуры Кюри T_C на 75°C, от 435°C для SrBi₂Nb₂O₉ до 360°C для SrBi₂NbTaO₉. Тангенс угла диэлектрических потерь уменьшился в 10 раз для SrBi₂Nb_{1.8}Ta_{0.2}O₉ по сравнению с нелегированным SBN. Очевидно, что уменьшение $\tan \delta$ приводит к увеличению d_{33} .

Пьезомодуль для всего ряда синтезированных соединений SrBi₂Nb_{2-x}Ta_xO₉ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) имеет величину от 12 до 17 pC/N, что позволяет сделать вывод о независимости пьезомодуля от степени ковалентности связей в кислородном октаэдре при изоморфном замещении.

Синтезированные соединения ряда SrBi₂Nb_{2-x}Ta_xO₉ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$) являются кандидатами для высокотемпературных пьезоэлектрических приложений.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание в сфере научной деятельности 2023 г., проект № FENW-2023-0015).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] B. Aurivillius. Arkiv. Kemi. **1**, 54, 463 (1949).
- [2] Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская. ФТТ **3**, 3, 651 (1961). G.A. Smolensky, V.A. Isupov, A.I. Agranovskaya. Sov. Phys. Solid State **3**, 3, 651 (1961).
- [3] I.A. Parinov, S.V. Zubkov. J. Adv. Dielectr. **14**, 06, 2340007 (2024).
- [4] E.C. Subbarao. J. Am. Ceram. Soc. **45**, 4, 166 (1962).
- [5] E.C. Subbarao. J. Chem. Phys. **34**, 2, 695 (1961).
- [6] C. Long, Q. Chang, Y. Wu, W. He, Y. Li, H. Fan. J. Mater. Chem. **3**, 34, 8852 (2015).
- [7] W.S. Woo, S.S. Won, C.W. Ahn, S.A. Chae, A. Ullah, I.W. Kim. J. Appl. Phys. **115**, 3, 034107 (2014).
- [8] T. Li, X.L. Li, Z. Zhao, H. Ji, Y. Dai. J. Integr. Ferroelectr. **162**, 1, 1 (2015).
- [9] S.V. Zubkov, I.A. Parinov, A.V. Nazarenko, Y.A. Kuprina. Springer Proceed. Mater. **20**, 163 (2023).
- [10] S. Dubey, O. Subohi, R. Kurchanic. Appl. Phys. A **124**, 7, 461 (2018).
- [11] S.V. Zubkov. J. Adv. Dielectrics **11**, 5, 2160016 (2021).
- [12] С.В. Зубков, В.Г. Власенко. ФТТ **59**, 12, 2303 (2017). [S.V. Zubkov, V.G. Vlasenko. Phys. Solid State **59**, 12, 2325 (2017).]
- [13] Y. Li, C.J. Lu, J. Su, Y.C. Zhang, C. Zhang, S.F. Zhao, X.X. Wang, D.J. Zhang, H.M. Yin. J. Alloys. Compd. **687**, 707 (2016).
- [14] J. Su, Y. Long, Q. Li, C. Lu, K. Liang, J. Li, L. Luo, L. Sun, X. Lu, J. Zhu. J. Alloys. Compd. **747**, 1002 (2018).
- [15] D.L. Zhang, L. Feng, W. Huang, W. Zhao, X. Li. J. Appl. Phys. **120**, 15, 154105 (2016).
- [16] F. Rehman, L. Wang, H.-B. Jin, P. Ahmad, Y. Zhao, J.-B. Li. J. Alloys. Compd. **709**, 686 (2017).
- [17] V. Koval, I. Skorvanek, G. Viola, M. Zhang, C. Jia, H. Yan. J. Phys. Chem. C **122**, 27, 15733 (2018).
- [18] P. Fang, P. Liu, Z. Xi, W. Long, X. Li. Mater. Sci. Eng. B **186**, 21 (2014).
- [19] A. Faraz, J. Ricote, R. Jimenez, T. Maity, M. Schmidt, N. Deepak, S. Roy, M.E. Pemble, L. Keeney. J. Appl. Phys. **123**, 12, 124101 (2018).
- [20] Y. Qiu, S. Zhao, Z. Wang. Mater. Lett. **170**, 89 (2016).
- [21] Y. Bai, J. Chen, S. Zhao. RSC Adv. **6**, 47, 41385 (2016).
- [22] D. Peng, H. Zou, C. Xu, X. Wang, X. Yao, J. Lin, T. Sun. AIP Adv. **2**, 4, 042187 (2012).
- [23] Z. Zhu, X. Li, W. Gu, J. Wang, H. Huang, R. Peng, X. Zhai, Z. Fu, Y. Lu. J. Alloys. Compd. **686**, 306 (2016).
- [24] Y. Li, M. Bian, N. Zhang, W. Bai, J. Yang, Y. Zhang, X. Tang, J. Chu. Ceram. Int. **45**, 7 Part A, 8634 (2019).
- [25] H. Sun, T. Yao, X. Xie, Y. Lu, Y. Wang, Z. Xu, J. Han, X. Chen. J. Colloid. Interf. Sci. **534**, 499 (2019).
- [26] Y. Shu, Q. Ma, L. Cao, Z. Ding, X. Chen, F. Yang. J. Alloys Compd. **773**, 934 (2019).
- [27] H. Zhao, H. Wang, Z. Cheng, Q. Fu, H. Tao, Z. Ma, T. Jia, H. Kimura, H. Li. Ceram. Int. **44**, 11, 13226 (2018).
- [28] Y. Huang, L. Mi, J. Qin, S. Bi, H.J. Seo. J. Am. Ceram. Soc. **102**, 6, 3555 (2019).
- [29] X.Z. Zuo, J. Yang, B. Yuan, D.P. Song, X.W. Tang, K.J. Zhang, X.B. Zhu, W.H. Song, J.M. Dai, Y.P. Sun. J. Appl. Phys. **117**, 11, 114101 (2015).
- [30] F. Rehman, L. Wang, H.-B. Jin, A. Bukhtiar, R. Zhang, Y. Zhao, J.-B. Li. J. Am. Ceram. Soc. **100**, 2, 602 (2017).

- [31] H. Zou, J. Li, X. Wang, D. Peng, Y. Li, X. Yao. *Opt. Mater. Express* **4**, 8, 1545 (2014).
- [32] C.A. Paz de Araujo, J.D. Cuchiaro, L.D. McMillan, M.C. Scott, J.F. Scott. *Nature* **374**, 6523, 627 (1995).
- [33] T. Kikuchi. *J. Less Common Met.* **48**, 2, 319 (1976).
- [34] C.A. Paz de Araujo, J.D. Cuchiaro, L.D. McMillan, M.C. Scott, J.F. Scott. *Nature* **374**, 6523, 627 (1995).
- [35] D.P. Volanti, L.S. Cavalcante, E.C. Paris, A.Z. Simões, D. Keyson, V.M. Longo, A.T. de Figueiredo, E. Longo, J.A. Varela, F.S. De Vicente, A.C. Hernandez. *Appl. Phys. Lett.* **90**, 26, 261913 (2007).
- [36] A. Ando, M. Kimura, Y. Sakabe. *Jpn. J. Appl. Phys.* **42**, 2R, 520 (2003).
- [37] S. Sen, R.N.P. Choudhary, P. Pramanik. *Ferroelectrics* **324**, 1, 121 (2005).
- [38] S.E. Park, J.A. Cho, T.K. Song, M.H. Kim, S.S. Kim, H.-S. Lee. *J. Electroceram.* **13**, 1, 51 (2004).
- [39] S. Huang, C. Feng, L. Chen, X. Wen. *Solid State Commun.* **133**, 6, 375 (2005).
- [40] S. Huang, C. Feng, M. Gu, Y. Li. *J. Alloys. Compd.* **472**, 1–2, 262 (2009).
- [41] L. Sun, C. Feng, L. Chen, S. Huang. *J. Appl. Phys.* **101**, 8, 084102 (2007).
- [42] R. Singh, V. Luthra, R.S. Rawat, R.P. Tandon. *Ceram. Int.* **41**, 4468 (2015).
- [43] B.J. Kennedy, Ismunandar. *J. Mater. Chem.* **9**, 2, 541 (2006).
- [44] P. Banerjee, A. Franco. *Mater. Chem. Phys.* **225**, 213 (2019).
- [45] Y. Wu, M.J. Forbess, S. Seraji, S.J. Limmer, T.P. Chou, C. Nguyen, G. Cao. *J. Appl. Phys.* **90**, 10, 5296 (2001).
- [46] T. Wei, C.Z. Zhao, Q.J. Zhou, Z.P. Li, Y.Q. Wang, L.S. Zhang. *Opt. Mater.* **36**, 7, 1209 (2014).
- [47] V. Shrivastava. *Ceram. Int.* **42**, 8, 10122 (2016).
- [48] M. Nagata, D.P. Vijay, X. Zhang, S.B. Desu. *Physica Status Solidi A* **157**, 1, 75 (1996).
- [49] P. Banerjee, A. Franco. *Physica Status Solidi* **214**, 10, 1700067 (2017).
- [50] Y. Shimakawa, Y. Kubo, Y. Tauchi, T. Kamiyama, H. Asano, F. Izumi. *Appl. Phys. Lett.* **77**, 17, 2749 (2000).
- [51] X. Du, I.-W. Chen. *J. Am. Ceram. Soc.* **81**, 12, 3253 (1998).
- [52] V.A. Isupov. *Ferroelectrics* **189**, 1, 211 (1996).
- [53] B.A. Исупов. *Неорган. материалы* **42**, 11, 1353 (2006). [V.A. Isupov. *Inorg. Mater.* **42**, 11, 1236 (2006).]
- [54] V.M. Goldschmidt. *Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente*. J. Dybwad, Oslo (1923–1927).
- [55] R.D. Shannon. *Acta Crystallographica A* **32**, 5, 751 (1976).
- [56] T. Obata, T. Manako, Y. Shimakawa, Y. Kubo. *Appl. Phys. Lett.* **74**, 2, 290 (1999).
- [57] N.C. Hyatt, J.A. Hriljac, T.P. Comyn. *Mater. Res. Bull.* **38**, 5, 837 (2003).
- [58] R.E. Cohen. *Nature* **358**, 6382, 136 (1992).
- [59] X. He, R. Chu, Z. Xu, Z. Yao, J. Hao. *RSC Adv.* **8**, 28, 15613 (2018).

Редактор Е.В. Толстякова